率が五倍を超え、かつ、当該幅が四〇ナノメートル未満のものに限る。）にタングステン又はコバルトを空隙が生じないように充塡するように設計した原子層堆積装置（（二）に該当するものを除く。）

ソ　〇・〇一パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において金属の層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの（レ（二）に該当するものを除く。）

（一）　ウエハーの基板温度を二〇〇度超五〇〇度未満に維持しながら、化学的気相成長法又は周期的堆積法により窒化タングステンの層を成膜するもの

（二）　ウエハーの基板温度を二〇〇度超五〇〇度未満に維持しながら、一三三・三パスカル超五三・三三キロパスカル未満の圧力で化学的気相成長法又は周期的堆積法によりタングステンの層を成膜するもの

［新設］

ツ　〇・〇一パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において金属の層を成膜するように設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの（レ（二）に該当するものを除く。）

（一）　バリヤー膜を用いずに選択的にタングステンを成長させるもの

（二）　バリヤー膜を用いずに選択的にモリブデンを成長させるもの

［新設］

ネ　ウエハーの基板温度を二〇〇度超五〇〇度未満に維持しながら、有機金属化合物を用いてルテニウムの層を成膜するように設計した装置（レ（八）に該当するものを除く。）

［新設］

ナ　空間的原子層堆積装置（回転軸をもつウエハーの支持台を有するものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　プラズマにより原子層を成膜するもの

（二）　プラズマ源を有するもの

（三）　プラズマ照射領域にプラズマを閉じ込めるためのプラズマシールド又は手段を有するもの

［新設］

ラ　四〇〇度超六五〇度未満の温度で成膜する装置又はウエハーが設置された空間とは異なる空間で発生させたラジカルにより化学反応を促進させることで成膜する装置であって、次の全てに該当するシリコン及び炭素を含む膜を形成するように設計したもの

（一）　五・三未満の比誘電率のもの

（二）　水平方向の開口部の寸法が七〇ナノメートル未満のパターンにおいて当該寸法に対する深さの比率が五倍を超えるもの

（三）　パターンのピッチが一〇〇ナノメートル未満の構造のもの

［新設］

ム　マスク（極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したものに限る。）に使用するための多層の反射膜をイオンビーム蒸着又は物理的気相成長法により成膜するように設計した装置

［新設］

ウ　シリコン（炭素を添加したものを含む。）又はシリコンゲルマニウム（炭素を添加したものを含む。）のエピタキシャル成長用に設計した装置であって、次の全てに該当するもの

（一）　複数のチャンバーを有し、かつ、複数の工程間において〇・〇一パスカル以下の真空状態又は水と酸素の分圧が〇・〇一パスカル未満の不活性な環境を維持することができるもの

（二）　前処理としてウエハーの表面を清浄化するために設計したチャンバーを一以上有するもの

（三）　エピタキシャル成長の動作温度が六八五度以下であるもの